



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H5610

对应国外型号
HIT5610

主要用途

作音频放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-25V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-1A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-25			V	$I_C=-10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	$I_C=-1mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10\mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	$V_{CB}=-20V, I_E=0$
HFE	直流电流增益	60		240		$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		-0.2	-0.5	V	$I_C=0.8A, I_B=-80mA$
V_{BE}	基极—发射极电压		-0.8	-1	V	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
f_T	特征频率		360		MHz	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
C_{ob}	共基极输出电容		38		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

分档及其标志

A	B	C
60—120	85—170	120—240